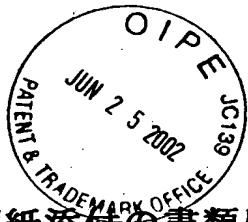


10/085,204



日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月27日

出願番号

Application Number:

特願2001-053200

[ST.10/C]:

[JP 2001-053200]

出願人

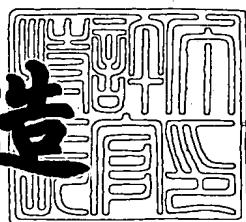
Applicant(s):

株式会社リユー

2002年 5月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3035039

【書類名】 特許願
【整理番号】 01001058
【提出日】 平成13年 2月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G02B 6/42
【発明の名称】 光送受信システム
【請求項の数】 7
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内
【氏名】 関谷 阜朗
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内
【氏名】 桜井 彰
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内
【氏名】 加藤 正良
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内
【氏名】 古田 輝幸
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内
【氏名】 宮垣 一也
【発明者】
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 金井 健

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 和多田 篤行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 俊一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 鈴木 幸栄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 菅原 悟

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 新治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 隅地 秀一

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】 桜井 正光

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003724

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光送受信システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 装置内部に設けられ、装置内部の通信を行うための光送受信システムであって、レーザ発光光源の光信号を空間伝送するとともに、前記光信号を受光するための受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、前記レーザ発光光源および受光ユニットのそれぞれの発光素子部および受光素子部には、それらの素子をカバーするカバー部材を設けたことを特徴とする光送受信システム。

【請求項2】 前記レーザ発光光源は、発振波長が1.1μm～1.7μmであり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層は $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料層は $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップであることを特徴とする請求項1記載の光送受信システム。

【請求項3】 前記レーザ発光光源は、発振波長が1.1μm～1.7μmであり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡で

あり、前記活性層と前記反射鏡の間にGaNPもしくはGaNPAsよりなる非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップであることを特徴とする請求項1記載の光送受信システム。

【請求項4】 前記装置は、電子写真原理を用いた記録装置であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の光送受信システム。

【請求項5】 前記装置は、インクジェット原理を用いた記録装置であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の光送受信システム。

【請求項6】 前記カバー部材は、ガラスで形成されたことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項記載の光送受信システム。

【請求項7】 前記カバー部材は、着脱可能であることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載の光送受信システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は光通信などに用いられる半導体レーザならびにその光送受信システムを機器内に組み込んだ場合の信頼性確保に関するものであり、中でも半導体レーザとして製作に使用する半導体基板面に対して垂直方向に光を発するいわゆる面発光レーザを用いた光送受信システムに関する。

【0002】

【従来の技術】

面発光半導体レーザは、基板の表面から垂直方向にレーザ光を放射するので2次元並列集積が可能であり、更に、その出力光の広がり角が比較的狭い（10度前後）ので光ファイバとの結合が容易であるほか、素子の検査が容易であるという特徴を有している。そのため、特に、並列伝送型の光送信モジュール（光インタコネクション装置）を構成するのに適した素子として開発が盛んに行なわれている。光インタコネクション装置の当面の応用対象は、コンピュータ等の筐体間やボード間の並列接続のほか、短距離の光ファイバー通信であるが、将来の期待される応用として大規模なコンピュータ・ネットワークや長距離大容量通信の幹線系がある。

【0003】

一般に、面発光半導体レーザは、GaAs 又はGaInAs からなる活性層と、当該活性層を上下に挟んで配置された上部の半導体分布プラグ反射鏡と基板側の下部の半導体分布プラグ反射鏡からなる光共振器をもって構成するのが普通であるが、端面発光型半導体レーザの場合に比較して光共振器の長さが著しく短いため、反射鏡の反射率を極めて高い値(99%以上)に設定することによってレーザ発振を起こし易くする必要がある。このため、通常は、AlAs からなる低屈折率材料とGaAs からなる高屈折率材料を1/4波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布プラグ反射鏡が使用されている。

【0004】

ところで上記のように、光通信に使用されるようなレーザ波長が1.1μm以上の長波長帯レーザ、例えばレーザ波長が1.3μm帯や1.55μm帯のような長波長帯レーザは、製作基板にInPが用いられ、活性層にInGaAsPが用いられるが、基板のInPの格子定数が大きく、これに整合する反射鏡材料では屈折率差が大きく取れず、従って積層数を40対以上とする必要がある。またInP基板上に形成される半導体レーザには、別の問題として、温度によって特性が大きく変化する点がある。そのため、温度を一定にする装置を附加して使用する必要があり、民生用等一般用に供することが困難であり、このような積層数と温度特性の問題から、実用的な長波長帯面発光半導体は、未だ実用化されるに至っていない。

【0005】

このような問題を解決するためになされた発明として、特開平9-237942号公報に開示されたものが知られている。それによると、製作基板としてGaAs 基板を用い、基板側の下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れるAlInP からなる半導体層を用い、さらに、下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布プラグ反射鏡の高屈折率層にGaInNAs からなる半導体層を用い、従来よりも大きい屈折率差を得るようにし、少ない積層数で高反射率の半導体分布プラグ反射鏡を実現しようというものである。

【0006】

また、 GaInNAs を活性層の材料として使用している。これは、N組成を増加させることによってバンドギャップ（禁制帯幅）を1.4 eVから0 eVへ向かって低下させることができるので、0.85 μm よりも長い波長を発光する材料として用いることが可能となるからである。しかも GaAs 基板と格子整合が可能なので、 GaInNAs からなる半導体層は、1.3 μm 帯及び1.55 μm 帯の長波長帯面発光半導体レーザのための材料として好ましい点についても言及している。

【0007】

しかしながら、従来は0.85 μm よりも長い波長帯の面発光半導体レーザ実現の可能性を示唆するにとどまっているだけであり、実際にはそのようなものは実現していない。これは基本的な構成は理論的にはほぼ決まっているものの実際に安定したレーザ発光が得られるようにするためのより具体的な構成がまだ不明だからである。

【0008】

一例を挙げると、上記のように AlAs からなる低屈折率材料と GaAs からなる高屈折率材料を1/4波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布プラグ反射鏡を使用したものや、あるいは特開平9-237942号公報に開示されたもののように、半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れる AlInP からなる半導体層を用いたものにおいては、レーザ素子が全く発光しなかったり、あるいは、発光してもその発光効率が低く、実用レベルには程遠いものであった。これは、 Al を含んだ材料が化学的に非常に活性であり、 Al に起因する結晶欠陥が生じ易いためである。これを解決するためには、特開平8-340146号公報や特開平7-307525号公報に開示された発明のように Al を含まない GaInNP と GaAs とから半導体分布プラグ反射鏡を構成する提案がある。しかしながら GaInNP と GaAs との屈折率差は AlAs と GaAs との屈折率差に比べて約半分であり、反射鏡の積層数を非常に多くなり製作が困難となる。

【0009】

すなわち現状では、コンピュータ・ネットワークやあるいは従来導線によって行っていた信号授受の分野においても光ファイバーを用いた光送受信システムへの期待が高まっているが、それに使用できるレーザ波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた光送受信システムが存在せず、その出現が切望されている。また近年構内の光送受信システムも構築されつつある。本発明者はこのような状況に鑑み、近い将来、他にもこのような光送受信システムが導入、構築されていくのではないかと考えた。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は機器内に設けられた光送受信システムに関するものであり、その第1の目的は、この光送受信システムが安定して動作するための構成を提案することにある。

【0011】

また第2の目的は、このような光送受信システムの発光光源として、レーザ発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザを使用した場合に、動作電圧、発振閾値電流等を低くできるようにすることにある。

【0012】

さらに第3の目的は、このような光送受信システムの発光光源として、レーザ発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザを使用した場合に、安定して発振、使用できるようにすることにある。

【0013】

また第4の目的は、このような光送受信システムを実際に機器内に組み込んだ場合に発生する特有な課題解決手段を提案することにある。

【0014】

さらに第5の目的も、このような光送受信システムを実際に機器内に組み込んだ場合に発生する特有な課題解決手段を提案することにある。

【0015】

また第6の目的は、このような光送受信システムを実際に機器内に組み込んだ場合に安定して機能するような構成を提案することにある。

【0016】

さらに第7の目的は、このような光送受信システムを実際に機器内に組み込んだ場合の長期信頼性を確保するための具体的な構成を提案することにある。

【0017】

【課題を解決するための手段】

本発明は前記目的を達成するために第1に、装置内部に設けられ、装置内部の通信を行うための光送受信システムであって、レーザ発光光源の光信号を空間伝送するとともに、前記光信号を受光するための受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、前記レーザ発光光源および受光ユニットのそれぞれの発光素子部および受光素子部には、それらの素子をカバーするカバー部材を設けるようにした。

【0018】

また第2に、上記第1の光送受信システムにおいて、前記レーザ発光光源は、発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料層は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップであるようにした。

【0019】

さらに第3に、上記第1の光送受信システムにおいて、前記レーザ発光光源は、発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡は

それを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によつて反射する半導体分布布拉ッグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $A_{1-x}Ga_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $A_{1-y}Ga_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、前記活性層と前記反射鏡の間に $GaInP$ もしくは $GaInPAs$ よりなる非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップであるようにした。

【0020】

また第4に、上記第1～第3の光送受信システムにおいて、前記装置は、電子写真原理を用いた記録装置とした。

【0021】

さらに第5に、上記第1～第3の光送受信システムにおいて、前記装置は、インクジェット原理を用いた記録装置とした。

【0022】

また第6に、上記第1～第5の光送受信システムにおいて、前記カバー部材は、ガラスで形成するようにした。

【0023】

さらに第7に、上記第1～第6の光送受信システムにおいて、前記カバー部材は、着脱可能であるようにした。

【0024】

【発明の実施の形態】

最初に本発明の光通信システムに適用される発光素子である伝送ロスの少ないレーザ発振波長が $1.1 \mu m$ ～ $1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの1例について図1を用いて説明する。

【0025】

前述のように、従来は本発明が適用しようとしているレーザ発振波長が $1.1 \mu m$ ～ $1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザに関しては、その可能性の示唆があるのみで、実現のための材料、ならびにより具体的、詳細な構成は不明であった。本発明では、活性層として $GaInNAs$ 等の材料を使用し、さらに具体的な構成を明確にした。以下にそれを詳述する。

【0026】

本発明では、面方位(100)のn-GaAs基板上に、それぞれの媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さ($\lambda/4$ の厚さ)でn-Al_xGa_{1-x}As($x=1, 0$) (低屈折率層～屈折率小の層)とn-Al_yGa_{1-y}As($y=0$) (高屈折率層～屈折率大の層)を交互に35周期積層したn-半導体分布プラッグ反射鏡(AlAs/GaAs下部半導体分布プラッグ反射鏡)を形成し、その上に $\lambda/4$ の厚さのn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}($x=0, 5, y=1$)層を積層した。この例ではn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}($x=0, 5, y=1$)層も下部反射鏡の一部であり低屈折率層(屈折率小の層)となっている。

【0027】

そしてその上にアンドープ下部GaAsスペーサ層と、3層のGa_xIn_{1-x}As量子井戸層である活性層(量子井戸活性層)とGaAsバリア層(20nm)からなる多重量子井戸活性層と、アンドープ上部GaAsスペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長 λ の1波長分の厚さ(λ の厚さ)の共振器を形成している。

【0028】

さらにその上に、C(炭素)ドープのp-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}($x=0, 5, y=1$)層とZnドープp-Al_xGa_{1-x}As($x=0$)をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さで交互に積層した周期構造(1周期)を積層し、その上にCドープのp-Al_xGa_{1-x}As($x=0, 9$)とZnドープp-Al_xGa_{1-x}As($x=0$)をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さで交互に積層した周期構造(25周期)とからなる半導体分布プラッグ反射鏡(Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs上部半導体分布プラッグ反射鏡)を形成している。この例ではp-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}($x=0, 5, y=1$)層も上部反射鏡の一部であり、低屈折率層(屈折率小の層)となっている。

【0029】

なおここで、上部/下部反射鏡ともそれぞれ低屈折率層(屈折率小の層)/高屈折率層(屈折率大の層)を交互に積層して形成するが、本発明ではこれらの間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層Al_zGa_{1-z}As($0 \leq y < z < x \leq 1$)

1) を設けている。図2は、低屈折率層(屈折率小の層)と高屈折率層(屈折率大の層)の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$)を設けた半導体分布プラグ反射鏡の一部を示したものである(図1では図が複雑になるので図示することを省略している)。

【0030】

従来レーザ波長が $0.85\text{ }\mu\text{m}$ 帯の半導体レーザに関して、このような材料層を設けることも検討はされているが、まだ検討段階であり、その材料、あるいはその厚さなどまで詳細には検討されていない。また本発明のようなレーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザに関しては全く検討されていない。その理由はこの分野(レーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザ)が新しい分野であり、まだほとんど研究が進んでいないからである。

【0031】

本発明者はいち早くこの分野(レーザ発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1.7\text{ }\mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた光通信)の有用性に気付き、それを実現するために銳意検討を行った。

【0032】

このような材料層は形成時にガス流量をコントロールするなどして、その Al 組成を連続的もしくは段階的に変えるようにしてその材料層の屈折率が連続的もしくは段階的に変化するようにして形成する。

【0033】

より具体的には、 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$)層の z の値を0から1.0まで変わるように、つまり $GaAs \sim AlGaAs \sim AlAs$ という具合に Al と Ga の比率が徐々に変わるようにして形成する。これは前述のように層形成時にガス流量をコントロールすることによって作成される。また、 Al と Ga の比率が前述のように連続的に変わるようにして形成しても良いし、段階的にその比率が変わるようにしても同等の効果がある。

【0034】

このような材料層を設ける理由は、半導体分布プラグ反射鏡の持つ問題点の

一つである p-半導体分布プラグ反射鏡の電気抵抗が高いという課題を解決するためである。これは半導体分布プラグ反射鏡を構成する2種類の半導体層の界面に生じるヘテロ障壁が原因であるが、本発明のように低屈折率層と高屈折率層の界面に一方の組成から他方の組成へ次第に A₁組成が変化するようにして、屈折率も変化させることによってヘテロ障壁の発生を抑制することが可能である。

【0035】

またこのような屈折率が小と大の間の値をとる材料層 A_{1-z}Ga_zAs (0 ≤ y < z < x ≤ 1) は本発明のようなレーザ発振波長が 1.1 μm ~ 1.7 μm の長波長帯面発光半導体レーザの場合、5 nm ~ 50 nm の厚さとするのが良く、これより薄いと抵抗が大となり電流が流れにくく、素子が発熱したり、駆動エネルギーが高くなるという不具合がある。また厚いと抵抗が小となり、素子の発熱や、駆動エネルギーの面で有利になるが、今度は反射率がとれないという不具合があり、前述のように最適の範囲 (5 nm ~ 50 nm の厚さ) を選ぶ必要がある。

【0036】

なお、前述のように従来のレーザ波長が 0.85 μm 帯の半導体レーザに関してこのような材料層を設けることも検討されているが、本発明のようなレーザ発振波長が 1.1 μm ~ 1.7 μm の長波長帯面発光半導体レーザの場合は、より効果的である。なぜなら、例えば同等の反射率 (例えば 99.5% 以上) を得るために、0.85 μm 帯よりも 1.1 μm 帯 ~ 1.7 μm 帯の場合、このような材料層を約 2 倍程度にすることができるので、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができ、動作電圧、発振閾値電流等が低くなり、レーザ素子の発熱防止ならびに安定発振、少エネルギー駆動の面で有利となる。

【0037】

つまり半導体分布プラグ反射鏡にこのような材料層を設けることは、本発明のようなレーザ発振波長が 1.1 μm ~ 1.7 μm の長波長帯面発光半導体レーザの場合に特に効果的な工夫といえる。

【0038】

なお効果的な反射率を得るためのより詳細な検討結果の一例を挙げると、例えば1. 3 μm帯面発光型レーザ素子では、 $Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 1.0$) (低屈折率層～屈折率小の層) と $Al_yGa_{1-y}As$ ($y = 0$) (高屈折率層～屈折率大の層) を20周期積層した場合においては、半導体分布プラグ反射鏡の反射率が99.7%以下となる $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) 層の厚さは30 nmである。また、反射率が99.5%以上となる波長帯域は53 nmであり、反射率を99.5%以上と設計した場合、±2%の膜厚制御ができればよい。そこでこれと同等およびこれより薄い、10 nm、20 nm、30 nmのものを試作したところ、反射率を実用上問題のない程度に保つことができ、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができた1. 3 μm帯面発光型レーザ素子を実現、レーザ発振に成功した。なお試作したレーザ素子の他の構成は後述のとおりである。

【0039】

なお多層膜反射鏡においては設計波長（膜厚制御が完全にできたとして）を含んで反射率の高い帯域がある。高反射率の帯域（反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域を含む）と呼ぶ。設計波長の反射率が最も高く、波長が離れるにしたがってごくわずかずつ低下している領域である。これはある領域から急激に低下する。そして狙いの波長に対して必要な反射率以上となるように、本来、多層膜反射鏡の膜厚を原子層レベルで完全に制御する必要がある。しかし実際には±1%程度の膜厚誤差は生じるので狙いの波長と最も反射率の高い波長はずれてしまう。例えば狙いの波長が1. 3 μmの場合、膜厚制御が1%ずれたとき、最も反射率の高い波長は13 nmずれてしまう。よってこの高反射率の帯域（ここでは反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域）は広い方が望ましい。しかし中間層を厚くするとこの帯域が狭くなる傾向にある。

【0040】

このように本発明のようなレーザ発振波長が1. 1 μm～1. 7 μmの長波長帯面発光半導体レーザにおいて、このような半導体分布プラグ反射鏡の構成を工夫、最適化することにより、反射率を高く維持したまま抵抗値を低減させることができるので、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱防止

ならびに安定発振、少エネルギー駆動が可能となる。

【0041】

再び図1に戻り、最上部の、 $p - Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0$) 層は、電極とコントタクトを取るためのコンタクト層 (p -コンタクト層) としての役割も持っている。

【0042】

ここで、量子井戸活性層の In 組成 x は 39% ($Ga0.61In0.39As$) とした。また量子井戸活性層の厚さは 7 nm とした。なお量子井戸活性層は、 $GaAs$ 基板に対して約 2.8% の圧縮歪を有していた。

【0043】

またこの面発光型半導体レーザ全体の成長方法は MOCVD 法で行った。この場合、格子緩和は見られなかった。半導体レーザの各層を構成する原料には、 TMA (トリメチルアルミニウム)、 TMG (トリメチルガリウム)、 TMi (トリメチルインジウム)、 AsH_3 (アルシン)、 PH_3 (fosfin) を用いた。また、キャリアガスには H_2 を用いた。図1に示した素子の活性層 (量子井戸活性層) のように歪が大きい場合は、非平衡となる低温成長が好ましい。ここでは、 $GaInAs$ 層 (量子井戸活性層) は 550°C で成長させている。ここで使用した MOCVD 法は過飽和度が高く高歪活性層の結晶成長に適している。また MBE 法のような高真空を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0044】

またこの例では、電流経路外の部分をプロトン (H^+) 照射によって絶縁層 (高抵抗部) を作って、電流狭さく部を形成した。

【0045】

そしてこの例では、上部反射鏡の最上部の層であり上部反射鏡一部となっている p -コンタクト層上に光出射部を除いて p 側電極を形成し、基板の裏面に n 側電極を形成した。

【0046】

この例では、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域

(本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器)において、活性領域内にはAlを含んだ材料(III族に占める割合が1%以上)を用いず、さらに、下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層を $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$)の非発光再結合防止層としている。キャリアは、活性層に最も近くワイドギャップである上部及び下部反射鏡の低屈折率層間に閉じ込められるので、活性領域のみをAlを含まない層(II族に占める割合が1%以下)で構成しても活性領域に接する反射鏡の低屈折率層(ワイドギャップ層)にAlを含んだ構造としたのでは、キャリアが注入され再結合する時、この界面で非発光再結合が生じ発光効率は低下してしまう。よって活性領域はAlを含まない層で構成することが望ましい。

【0047】

またこの $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$)層よりなる非発光再結合防止層は、その格子定数がGaAs基板よりも小さく、引張り歪を有している。

【0048】

エピタキシャル成長では下地の情報を反映して成長するので基板表面に欠陥があると成長層へ這い上がっていく。しかし歪層があるとそのような欠陥の這い上がりが抑えられ効果があることが知られている。

【0049】

上記欠陥が活性層に達すると発光効率を低減させてしまう。また、歪を有する活性層では臨界膜厚が低減し必要な厚さの層を成長できないなどの問題が生じる。特に活性層の圧縮歪量が例えば2%以上と大きい場合や、歪層の厚さ臨界膜厚より厚く成長する場合、低温成長などの非平衡成長を行っても欠陥の存在で成長できないなど、特に問題となる。歪層があるとそのような欠陥の這い上がりが抑えられるので、発光効率を改善したり、活性層の圧縮歪量が例えば2%以上の層を成長できたり、歪層の厚さを臨界膜厚より厚く成長することが可能となる。

【0050】

この $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$)層は活性領域に接しており活性領域にキャリアを閉じ込める役割も持っているが、 $Ga_xIn_{1-x}P_y$

As_{1-y} ($0 < x < 1$, $0 < y \leq 1$) 層は格子定数が小さくなるほどバンドギャップエネルギーを大きく取り得る。例えば $Ga_xIn_{1-x}P$ ($y = 1$ の場合) の場合、 x が大きくなり GaP に近づくと格子定数が大きくなり、バンドギャップは大きくなる。バンドギャップ Eg は、直接遷移で $Eg(\Gamma) = 1.351 + 0.643x + 0.786x^2$ 、間接遷移で $Eg(X) = 2.24 + 0.02x$ と与えられている。よって活性領域と $Ga_xIn_{1-x}PyAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$, $0 < y \leq 1$) 層のヘテロ障壁は大きくなるのでキャリア閉じ込めが良好となり、しきい値電流低減、温度特性改善などの効果がある。

【0051】

さらにこの $Ga_xIn_{1-x}PyAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$, $0 < y \leq 1$) 層よりなる非発光再結合防止層は、その格子定数が $GaAs$ 基板よりも大きく、圧縮歪を有しており、かつ前記活性層の格子定数が前記 $Ga_xIn_{1-x}PyAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$, $0 < y \leq 1$) 層よりも大きく圧縮歪を有している。

【0052】

またこの $Ga_xIn_{1-x}PyAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$, $0 < y \leq 1$) 層の歪の方向が活性層と同じ方向なので、活性層が感じる実質的な圧縮歪量を低減する方向に働く。歪が大きいほど外的要因の影響を受けやすいので、活性層の圧縮歪量が例えば 2% 以上と大きい場合や、臨界膜厚を超えた場合に特に有効である。

【0053】

例えば発振波長が $1.3 \mu m$ 帯の面発光型レーザは $GaAs$ 基板上に形成するのが好ましく、共振器には半導体多層膜反射鏡を用いる場合が多く、トータル厚さが $5 \sim 8 \mu m$ で $50 \sim 80$ 層の半導体層を活性層成長前に成長する必要がある。（一方、端面発光型レーザの場合、活性層成長前のトータル厚さは $2 \mu m$ 程度で 3 層程度の半導体層を成長するだけで良い。）この場合、高品質の $GaAs$ 基板を用いてもさまざまな原因（一度発生した欠陥は基本的には結晶成長方向に這い上がるし、ヘテロ界面での欠陥発生などがある）で $GaAs$ 基板表面の欠陥密度に比べて活性層成長直前の表面の欠陥密度はどうしても増えてしまう。活性層成長以前に、歪層の挿入や、活性層が感じる実質的な圧縮歪量が低減すると、活性層成長直前の表面にある欠陥の影響を低減できるようになる。

【0054】

この例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面にA1を含まない構成としたので、キャリア注入時にA1に起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合がなくなり、非発光再結合が低減した。

【0055】

前述のように、反射鏡と活性領域との界面にA1を含まない構成とする、すなわち非発光再結合防止層を設けることを、上下反射鏡ともに適用することが好ましいが、一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラグ反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラグ反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。また前述の例では、反射鏡低屈折率層の最も活性層に近い層のみを $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としているが、複数層の $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) を非発光再結合防止層としても良い。

【0056】

さらにこの例では、GaAs基板と活性層との間の下部反射鏡にこの考えを適用し、活性層の成長時に問題となる、A1に起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。これらにより、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分をA1を含まない $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) 層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができている。

【0057】

このようにして製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約1.2μmであった。GaAs基板上のGaInAsは、In組成の増加で長波長化するが歪み量の増加をともない、従来1.1μmまでが長波長化の限界と考えられていた（文献「IEEE Photonics Technol. Lett. Vol. 9 (1997) p.p. 1319-1321」参照）。

【0058】

しかしながら今回発明者が製作したように、600°C以下の低温成長などの非平衡度の高い成長法により高歪のGaInAs量子井戸活性層を従来より厚くコヒーレント成長することが可能となり、波長は1.2 μmまで到達できた。なおこの波長はSi半導体基板に対して透明である。従ってSi基板上に電子素子と光素子を集積した回路チップにおいてSi基板を通した光伝送が可能となる。

【0059】

以上の説明より明らかなようにIn組成が大きい高圧縮歪のGaInAsを活性層に用いることにより、GaAs基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できることがわかった。

【0060】

なお前述のように、このような面発光型半導体レーザは、MOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また活性層の積層構造として、3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、MQW)等を用いることもできる。

【0061】

レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。また共振器長はλの厚さとしたがλ/2の整数倍とすることができる。望ましくはλの整数倍である。また半導体基板としてGaAsを用いた例を示したが、InPなどの他の半導体基板を用いた場合でも上記の考え方を適用できる。反射鏡の周期は他の周期でも良い。

【0062】

なおこの例では活性層として、主たる元素がGa、In、Asよりなる層、すなわち $Ga_xIn_{1-x}As$ (GaInAs活性層)の例を示したが、より長波長のレーザ発振を行うためには、Nを添加し主たる元素がGa、In、N、Asからなる層(GaInNAs活性層)とすればよい。

【0063】

実際にGaInNAs活性層の組成を変えることにより、1.3 μm帯、1.55 μm帯のそれぞれにおいて、レーザ発振を行うことが可能であった。組成を検討することにより、さらに長波長の例えば1.7 μm帯の面発光レーザも可能となる。

【0064】

また、活性層に GaAsSb を用いても GaAs 基板上に $1.3 \mu\text{m}$ 帯面発光レーザを実現できる。このように波長 $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪の GaInAs 、 GaInNAs 、 GaAsSb を用い、かつ、非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長 $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ 帯の長波長領域において、高性能な面発光レーザを実現できるようになった。

【0065】

次に本発明の光送受信システムに適用される発光素子である長波長帯面発光型半導体レーザの他の構成について、図3を用いて説明する。

【0066】

この場合も図1の場合と同様に面方位(100)の $n-\text{GaAs}$ 基板を使用している。それぞれの媒質内における発振波長 λ の $1/4$ 倍の厚さ ($\lambda/4$ の厚さ) で $n-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($x=0.9$) と $n-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($x=0$) を交互に35周期積層した n -半導体分布布拉ック反射鏡 ($\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}/\text{GaAs}$ 下部反射鏡) を形成し、その上に $\lambda/4$ の厚さの $n-\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ ($x=0.5$ 、 $y=1$) 層を積層した。この例では $n-\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ ($x=0.5$ 、 $y=1$) 層も下部反射鏡の一部であり低屈折率層となっている。

【0067】

そしてその上に、アンドープ下部 GaAs スペーサ層と、3層の $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{N}_y\text{As}_{1-y}$ 量子井戸層である活性層(量子井戸活性層)と GaAs バリア層 (1.5 nm) から構成される多重量子井戸活性層(この例では3重量子井戸(TQW))と、アンドープ上部 GaAs スペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長の1波長分の厚さ (λ の厚さ) の共振器を形成している。

【0068】

さらにその上に、 p -半導体分布布拉ック反射鏡(上部反射鏡)が形成されている。

【0069】

上部反射鏡は、被選択酸化層となる AlAs 層を、 GaInP 層と AlGaA

s層で挟んだ $3\lambda/4$ の厚さの低屈折率層（厚さが $(\lambda/4 - 15\text{ nm})$ ）のCドープ $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ （ $x = 0.5, y = 1$ ）層、Cドープ $p-Al_zGa_{1-z}As$ （ $z = 1$ ）被選択酸化層（厚さ 30 nm ）、厚さが $(2\lambda/4 - 15\text{ nm})$ のCドープ $p-Al_xGa_{1-x}As$ 層（ $x = 0.9$ ）と、厚さが $\lambda/4$ の $GaAs$ 層（1周期）と、Cドープの $p-Al_xGa_{1-x}As$ 層（ $x = 0.9$ ）と $p-Al_xGa_{1-x}As$ （ $x = 0$ ）層をそれぞれの媒質内における発振波長の $1/4$ 倍の厚さで交互に積層した周期構造（22周期）とから構成されている半導体分布プラグ反射鏡（ $Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs$ 上部反射鏡）である。

【0070】

なおこの例においても、図3では複雑になるので図示することは省略しているが、半導体分布プラグ反射鏡の構造は、図2に示したような低屈折率層（屈折率小の層）と高屈折率層（屈折率大の層）の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ （ $0 \leq y < z < x \leq 1$ ）を設けたものである。

【0071】

そして、最上部の、 $p-Al_xGa_{1-x}As$ （ $x = 0$ ）層は、電極とコンタクトを取るためのコンタクト層（p-コンタクト層）としての役割も持たせている。

【0072】

ここで量子井戸活性層の In 組成 x は37%、N（窒素）組成は0.5%とした。また量子井戸活性層の厚さは7nmとした。

【0073】

またこの面発光型半導体レーザの成長方法はMOCVD法を行った。半導体レーザの各層を構成する原料には、TMA（トリメチルアルミニウム）、TMG（トリメチルガリウム）、TMI（トリメチルインジウム）、 AsH_3 （アルシン）、 PH_3 （fosfin）、そして窒素の原料には $DMHy$ （ジメチルヒドラン）を用いた。 $DMHy$ は低温で分解するので600°C以下の低温成長に適しており、特に低温成長の必要な歪みの大きい量子井戸層を成長する場合に好ましい。なおキャリアガスには H_2 を用いた。

【0074】

またこの例では、 $GaInNAs$ 層（量子井戸活性層）は540°Cで成長した

。MOCVD法は過飽和度が高くNと他のV族を同時に含んだ材料の結晶成長に適している。またMBE法のような高真空を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0075】

さらにこの例では、所定の大きさのメサ部分を $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($x = 0.5, y = 1$) 層に達するまで、 $p-Al_zGa_{1-z}As$ ($z = 1$) 被選択酸化層の側面を露出させて形成し、側面の現れた $Al_zGa_{1-z}As$ ($z = 1$) 層を水蒸気で側面から酸化して Al_xO_y 電流狭さく層を形成している。

【0076】

最後にポリイミド（絶縁膜）でメサエッチングで除去した部分を埋め込んで平坦化し、上部反射鏡上のポリイミドを除去し、p-コンタクト層上に光出射部を除いてp側電極を形成し、GaAs基板の裏面にn側電極を形成した。

【0077】

この例においては、被選択酸化層の下部に上部反射鏡の一部として $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層が挿入している。例えばウェットエッチングの場合では、硫酸系エッチャントを用いれば、AlGaAs系に対してGaInPAs系はエッチング停止層として用いることができるため、 $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層が挿入されていることで、選択酸化のためのメサエッチングの高さを厳密に制御できる。このため、均一性、再現性を高められ、低コスト化が図れる。

【0078】

またこの例の面発光型半導体レーザ（素子）を一次元または二次元に集積した場合、素子製作時における制御性が良好になることにより、アレイ内の各素子の素子特性の均一性、再現性も極めて良好になるという効果がある。

【0079】

なおこの例では、エッチングストップ層を兼ねる $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層を上部反射鏡側に設けたが、下部反射鏡側に設けても良い。

【0080】

またこの例においても、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域（本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器）において、活性領域内にはA₁を含んだ材料を用いず、さらに下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層をG_a_xI_n_{1-x}P_yA_s_{1-y}（0 < x < 1、0 < y ≤ 1）の非発光再結合防止層としている。つまりこの例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面に、A₁を含まない構成としているので、キャリア注入時に、A₁に起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合を低減させることができる。

【0081】

なお反射鏡と活性領域との界面にA₁を含まない構成を、この例のように上下反射鏡に適用することが好ましいが、いずれか一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラック反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラック反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。

【0082】

さらにこの例でも、G_aA_s基板と活性層との間の下部反射鏡に図1の例の場合と同様の考えを適用したので、活性層の成長時に問題となるA₁に起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。

【0083】

なお、このような非発光再結合防止層は、図1、図3のいずれの構成においても半導体分布プラック反射鏡の一部を構成するので、その厚さは、媒質内における発振波長λの1/4倍の厚さ（λ/4の厚さ）としている。あるいはそれを複数層も設けても良い。

【0084】

以上の説明より明らかなように、このような構成により、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラック反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分をA₁を含まないG_a_xI_n_{1-x}P_yA_s_{1-y}（0 < x < 1、0 < y ≤ 1）の非発光再

結合防止層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができた。

【0085】

またこのような構成にしても、ポリイミドの埋め込みは容易であるので、配線（この例ではp側電極）が段切れしにくく、素子の信頼性は高いものが得られる。

【0086】

このように製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約1.3μmであった。

【0087】

この例では、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層を活性層に用いた（GaInNAs活性層）ので、GaAs基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できた。またAlとAsを主成分とした被選択酸化層の選択酸化により電流狭さくを行ったので、しきい値電流は低かった。

【0088】

被選択酸化層を選択酸化したAl酸化膜からなる電流狭さく層を用いた電流狭さく構造によると、電流狭さく層を活性層に近づけて形成することで電流の広がりを抑えられ、大気に触れない微小領域に効率良くキャリアを閉じ込めることができる。更に酸化してAl酸化膜となることで屈折率が小さくなり凸レンズの効果でキャリアの閉じ込められた微小領域に効率良く光を閉じ込めることができ、極めて効率が良くなり、しきい値電流は低減できる。また容易に電流狭さく構造を形成できることから、製造コストを低減できる。

【0089】

以上の説明から明らかなように図3のような構成においても図1の場合と同様に、1.3μm帯の面発光型半導体レーザを実現でき、しかも低消費電力で低コストの素子が得られる。

【0090】

なお、図3の面発光型半導体レーザも図1の場合と同様にMOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また

窒素の原料に、DMHyを用いたが、活性化した窒素やNH₃等他の窒素化合物を用いることもできる。

【0091】

さらに活性層の積層構造として3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、DQW、MQW)等を用いることもできる。レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。

【0092】

また図3の面発光型半導体レーザにおいて、GaInNAs活性層の組成を変えることで、1.55μm帯、更にはもっと長波長の1.7μm帯の面発光型半導体レーザも可能となる。GaInNAs活性層にTl、Sb、Pなど他のIII-V族元素が含まれていてもかまわない。また活性層にGaAsSbを用いても、GaAs基板上に1.3μm帯の面発光型半導体レーザを実現できる。

【0093】

なお活性層にGaInNAsを用いた場合、従来1.1μmまでが長波長化の限界と考えられていたが、600℃以下の低温成長により高歪のGaInNAs量子井戸活性層を従来よりも厚く成長することが可能となり、波長は1.2μmまで到達できる。このように、波長1.1μm～1.7μmの半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪のGaInAs、GaInNAs、GaAsSbを用い、かつ非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長1.1μm～1.7μm帯の長波長領域において、高性能な面発光レーザを実現できるようになり、光通信システムへの応用ができるようになった。

【0094】

図4はこのような長波長帯面発光半導体レーザ素子を、面方位(100)のn-GaAsウエハに多数のチップとして形成した例、ならびにレーザ素子チップを示したものである。ここで示したレーザ素子チップには、1～n個のレーザ素子が形成されているが、その個数nはその用途に応じて、数ならびに配列方法が決められる。

【0095】

図5は本発明の光送受信システムの一例である。この例ではレーザ素子発光部から出た光信号は空間伝送され、図の矢印方向に直進し、フォトダイオード等の受光素子の光ディテクタ部で受け取られる。

【0096】

好適に利用できるレーザ素子としては、上記説明のように半導体分布プラグ反射鏡の工夫、あるいは非発光再結合防止層を設けるような工夫により、従来実現し得なかったレーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の面発光型半導体レーザが、信頼性の面、低エネルギー駆動の面、製造上の低コスト化の面から好ましい。

【0097】

以下の説明では、レーザ素子が1個の例で説明するが、本発明のような1.1μm帯～1.7μm帯の長波長帯面発光半導体レーザが、1個のチップの上に簡単に多数のレーザ素子が安価に製作できるので、マルチレーザアレイ方式が簡単に実現でき、大容量の情報やり取りが実現する。

【0098】

図6は本発明の光送受信システムの他の例である。この例では、レーザ素子発光部から出た光信号は空間伝送され、図の矢印方向に直進しするが、途中で例えば反射部材によって、その直進方向が曲げられ、フォトダイオード等の受光素子の光ディテクタ部で受け取られる。

【0099】

従来このような信号のやり取りは導線ケーブルを用いる電気信号で行っている。したがって各種エレクトロニクス機器は、その機器内部は無数の導線ケーブルで接続されており、その導線ケーブルの配置／処理が煩雑であり、設計段階あるいは工場の組み立て段階で問題となっていた。

【0100】

そこで本発明では、このような導線ケーブルによる信号のやり取りではなく、図5あるいは図6のような光送受信システムによって、信号を光に置き換えるとともに、光信号を空間伝送させ、導線ケーブルをなくして（あるいは少なくして）、機器内部の導線ケーブルをできるだけ少なくして、内部をすっきりさせ、導

線ケーブルのレイアウト上の処理の煩雑さをなくし、機器内部の各部品／ユニット等のレイアウトの自由度が増えるようにしたのである。

【0101】

このような本発明の光送受信システムが組み込まれるエレクトロニクス機器として、例えば複写機やレーザープリンターのような電子写真原理を用いた記録装置、あるいはインクジェット記録装置や銀塩写真プロセスの記録装置等があげられる。これら以外にもコンピュータ、ビデオ機器、テレビ受像機等にも使用できる。

【0102】

図7は本発明が好適に適用される電子写真複写機を示したものである。図8はそれを拡大し、内部も簡単に示した図である。

【0103】

本発明の光送受信システムは、たとえば図8に示した太矢印のように配置される。ここでは図6のような光送受信システムを、単純に横と縦の太矢印のみで示している。図のA部はレーザ素子発光部であり、B部は受光素子部である。反射部材は省略している。

【0104】

図9は本発明が好適に適用される他の例であり、インクジェット記録装置を示したものである。図10はそれを拡大し、内部も簡単に示した図である。

【0105】

本発明の光送受信システムは、たとえば図10に示した太矢印のように配置される。ここでは図5のような光送受信システムを、単純に横の太矢印のみで示している。図のA部はレーザ素子発光部であり、B部は受光素子部である。

【0106】

このように本発明では、各種エレクトロニクス機器の内部に導線ケーブルをなくして（あるいは少なくして）、光送受信システムによって、機器内部の信号のやり取りを行うものである。適用されるエレクトロニクス機器として、図7～図10では、それぞれ電子写真複写機とインクジェット記録装置を示したが、これらに限定されるものではない。

【0107】

ただし電子写真原理を用いた記録装置やインクジェット記録装置あるいは銀塩写真プロセスの記録装置等は、それらの装置特有の性質として、機器内部でトナー・や液体のインクあるいは液体の現像液が、そのもの単体で舞っていたり、あるいは紙粉といっしょに舞っていたり、またミスト状になって舞っていたりして、機器内部は本発明の光送受信システムにとってあまり好ましい環境とはいえない。

【0108】

このようなことを考慮して本発明では図11に示したように、レーザ発光光源および受光ユニットのそれぞれの発光素子部および受光素子部には、それらの素子をカバーするカバー部材を設けている。またそれらのカバーは例えばガラスのように光を透過する部材によって形成される。なおガラスでなくても内部の歪を取り除いた高精度のプラスチック部材であってもよい。このようなカバー部材は、高度な技術によって製作される本発明のレーザ素子や、受光素子を物理的にあるいは化学的に保護する役目を持っている。

【0109】

さらにトナー、インクあるいは紙粉等の異物が付着してきて、本発明の光送受信システムの機能を損ねる（光が遮光されて機能しなくなる）ようなことがあつてはならないので、これらのカバー部材は着脱可能とされ、異物が付着した場合にいつでもすぐに取りはずし、清浄化することができるようになっている。なお図11では反射部材にカバーを設けていないが、必要に応じて設けてもよい。

【0110】

以上のような点を考えるとこのようなカバーを設ける必然性がある機器としては、上記のコンピュータ、ビデオ機器、テレビ受像機等のようなものより、トナー・や紙を利用してトナー粉や紙粉が舞ったりする機器や、内部で液体を使用したりする機器といえ、そのような機器にはカバーを設けることが特に効果的に機能するといえる。

【0111】

【発明の効果】

【請求項1に対応した効果】

装置内部にレーザ発光光源の光信号を空間伝送する光送受信システムを設けたので、内部の信号授受をこの光送受信システムで行うことができ、装置内部で信号授受に使用する導線ケーブルを省略することが可能となった。従来ややもすると装置内部で信号授受に使用する導線ケーブルが複雑に入り組み、そのレイアウト上の処理が煩雑であったが、使用する導線ケーブルの数を減らすことができたので、煩雑さが解消できるのみならず、装置内部の各部品／ユニット等のレイアウトの自由度が増えた。またこの光送受信システムのレーザ発光光源および受光ユニットのそれぞれの発光素子部および受光素子部にそれらの素子をカバーするカバー部材を設けるようにしたので、発光素子部および受光素子部が装置内部を漂う異物などによって破損することが防止でき、この光送受信システムが安定して動作できるようになった。

【0112】

【請求項2に対応した効果】

このような装置内部の光送受信システムのレーザ発光光源として、レーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の面発光型半導体レーザを用いるとともに、この面発光型半導体レーザの半導体分布布拉格反射鏡を工夫したので、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱も少なく安定した発振ができるようになり、低コストで実用的な光送受信システムとすることができた。

【0113】

【請求項3に対応した効果】

このような装置内部の光送受信システムのレーザ発光光源として、レーザ発振波長が1.1μm帯～1.7μm帯の面発光型半導体レーザを用いるとともに、この面発光型半導体レーザの活性層と反射鏡の間に非発光再結合防止層を設けるようにしたので、安定して発振、使用できるようになり、実用的な光送受信システムとすることことができた。

【0114】

【請求項4に対応した効果】

このような光送受信システムを電子写真原理を用いた記録装置に設けることに

より、この装置内部で信号授受に使用する導線ケーブルを省略することが可能となった。また、このような記録装置は、装置内部で、トナーや紙粉が絶えず舞っていて、光送受信システムの発光素子部や受光素子部に悪影響を及ぼすが、本発明ではそれらの素子をカバーするカバー部材を設けるようにしたので、そのような悪影響を防止でき、この光送受信システムが安定して動作できるようになった。

【0115】

【請求項5に対応した効果】

このような光送受信システムをインクジェット原理を用いた記録装置に設けることにより、この装置内部で信号授受に使用する導線ケーブルを省略することが可能となった。また、このような記録装置は、装置内部で、液体のインクやそのミスト、紙粉等が絶えず舞っていて、光送受信システムの発光素子部や受光素子部に悪影響を及ぼす（特に液体であるインクが付着すると素子を破損する）が、本発明ではそれらの素子をカバーするカバー部材を設けるようにしたので、そのような悪影響を防止でき、この光送受信システムが安定して動作できるようになった。

【0116】

【請求項6に対応した効果】

このような光送受信システムの発光素子部や受光素子部をカバーするカバー部材をガラスにしたので安価に製作でき、また光透過も妨げないので、良好に機能する光送受信システムとすることことができた。

【0117】

【請求項7に対応した効果】

このような光送受信システムの発光素子部や受光素子部をカバーするカバー部材を着脱可能としたので、その表面にトナー、インク、紙粉等の異物が付着しても、簡単に取り外して清浄化して再び取り付けられるので、長期にわたり良好に機能する長期的信頼性の高い光送受信システムとすることことができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】

BEST AVAILABLE COPY

出願人履歴情報

識別番号 [00006747]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
氏 名 株式会社リコー

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの素子部断面図である

BEST AVAILABLE COPY

【図2】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの半導体分布プラッグ反射鏡の構成の部分断面図である。

【図3】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの他の構成の素子部断面図である。

【図4】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザ素子を形成したウエハ基板ならびにレーザ素子チップを示す平面図である。

【図5】

本発明の光送受信システムの一例を示す概念図である。

【図6】

本発明の光送受信システムの他の例を示す概念図である。

【図7】

本発明が好適に適用される電子写真複写機の一例である。

【図8】

本発明の光送受信システムを内蔵した電子写真複写機の一例である。

【図9】

本発明が好適に適用されるインクジェット記録装置の一例である。

【図10】

本発明の光送受信システムを内蔵したインクジェット記録装置の一例である。

【図11】

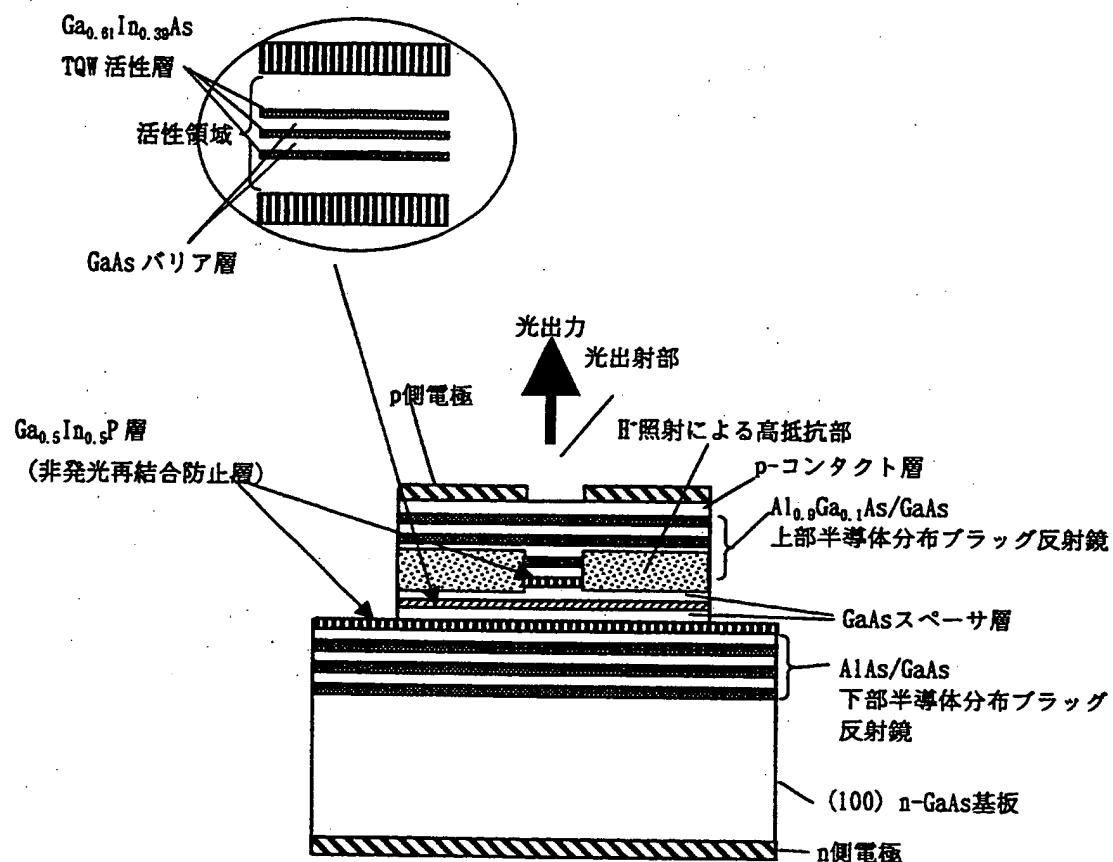
本発明の光送受信システムのさらに他の例を示す概念図である。

【書類名】

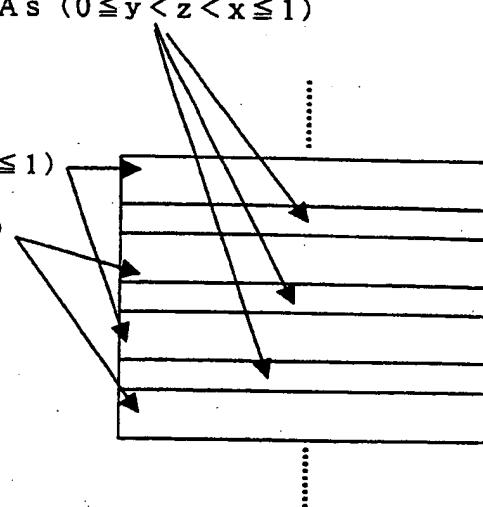
図面

【図1】

BEST AVAILABLE COPY

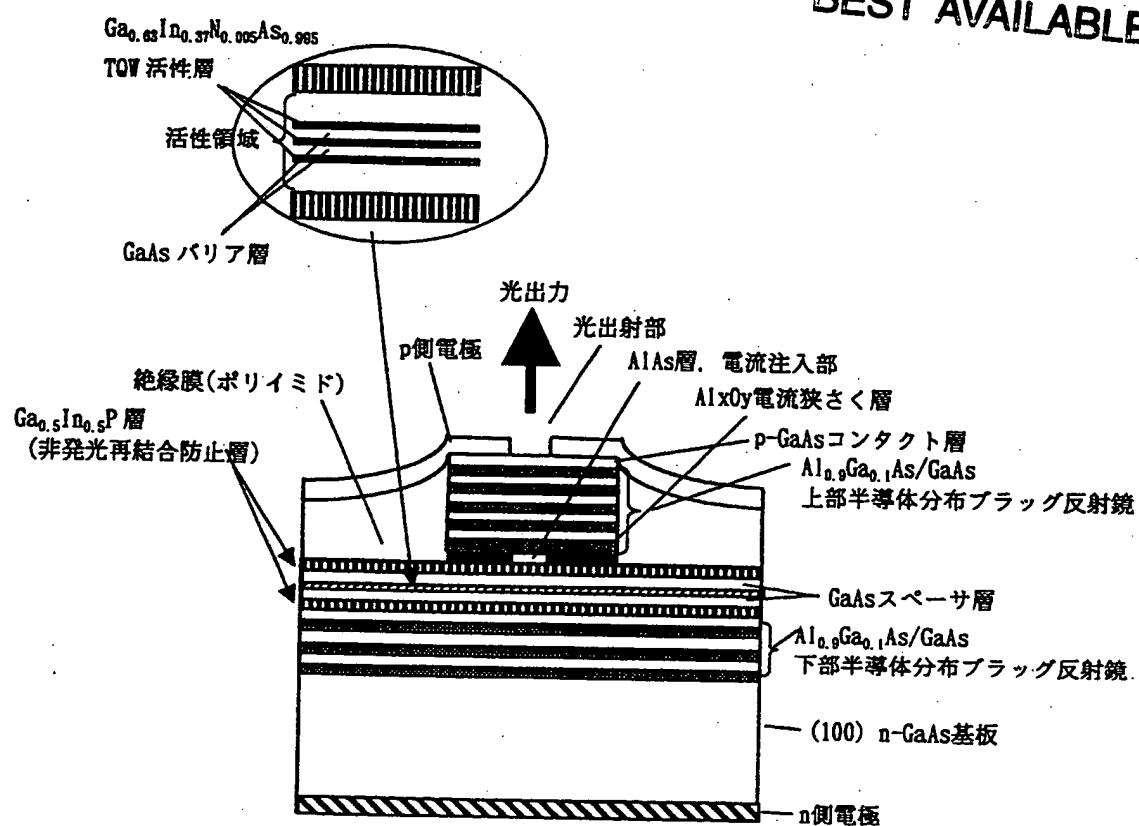


【図2】

屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$)屈折率が大の材料層 $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$)屈折率が小の材料層 $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$)

【図3】

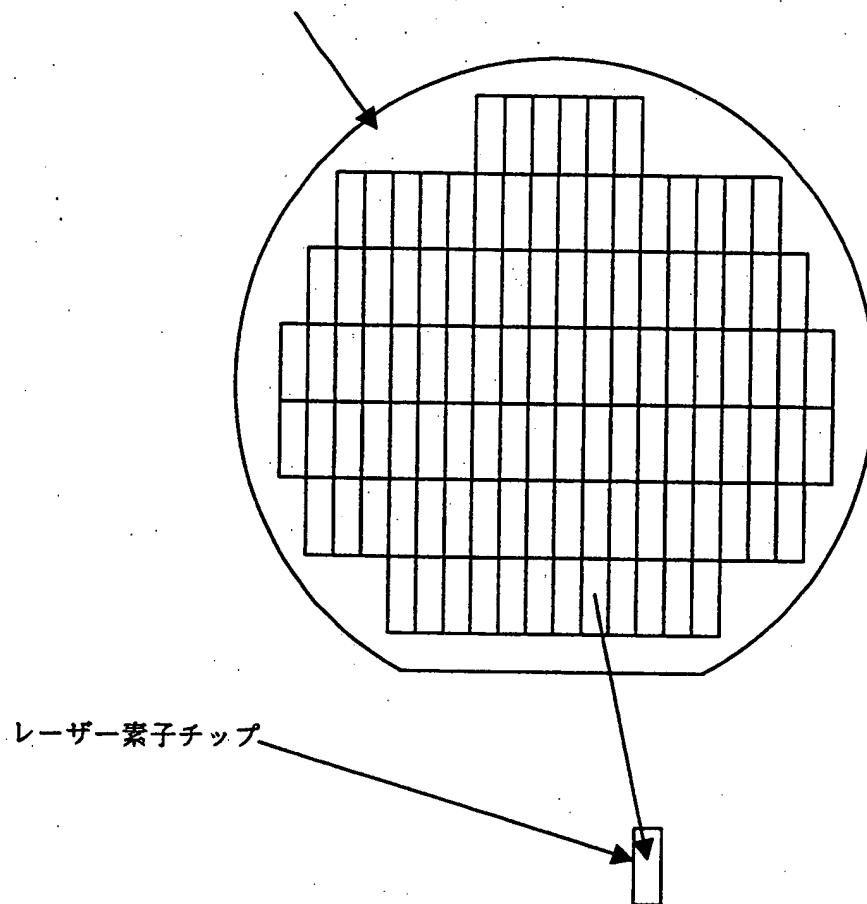
BEST AVAILABLE COPY



【図4】

レーザー素子を形成した(100)n-GaAsウェハ

BEST AVAILABLE COPY



【図5】

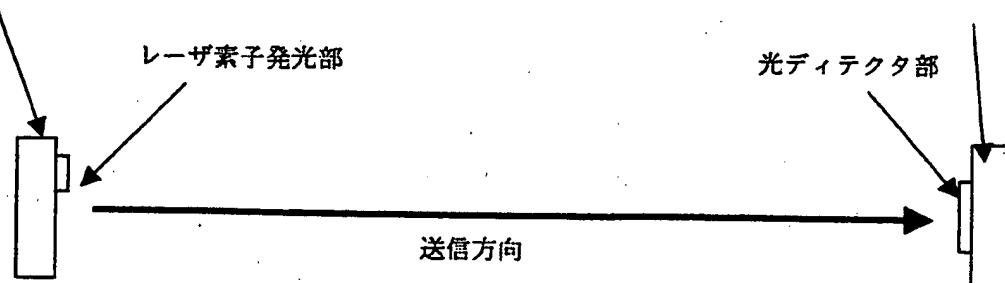
面発光型半導体レーザLDチップ

フォトダイオードチップ

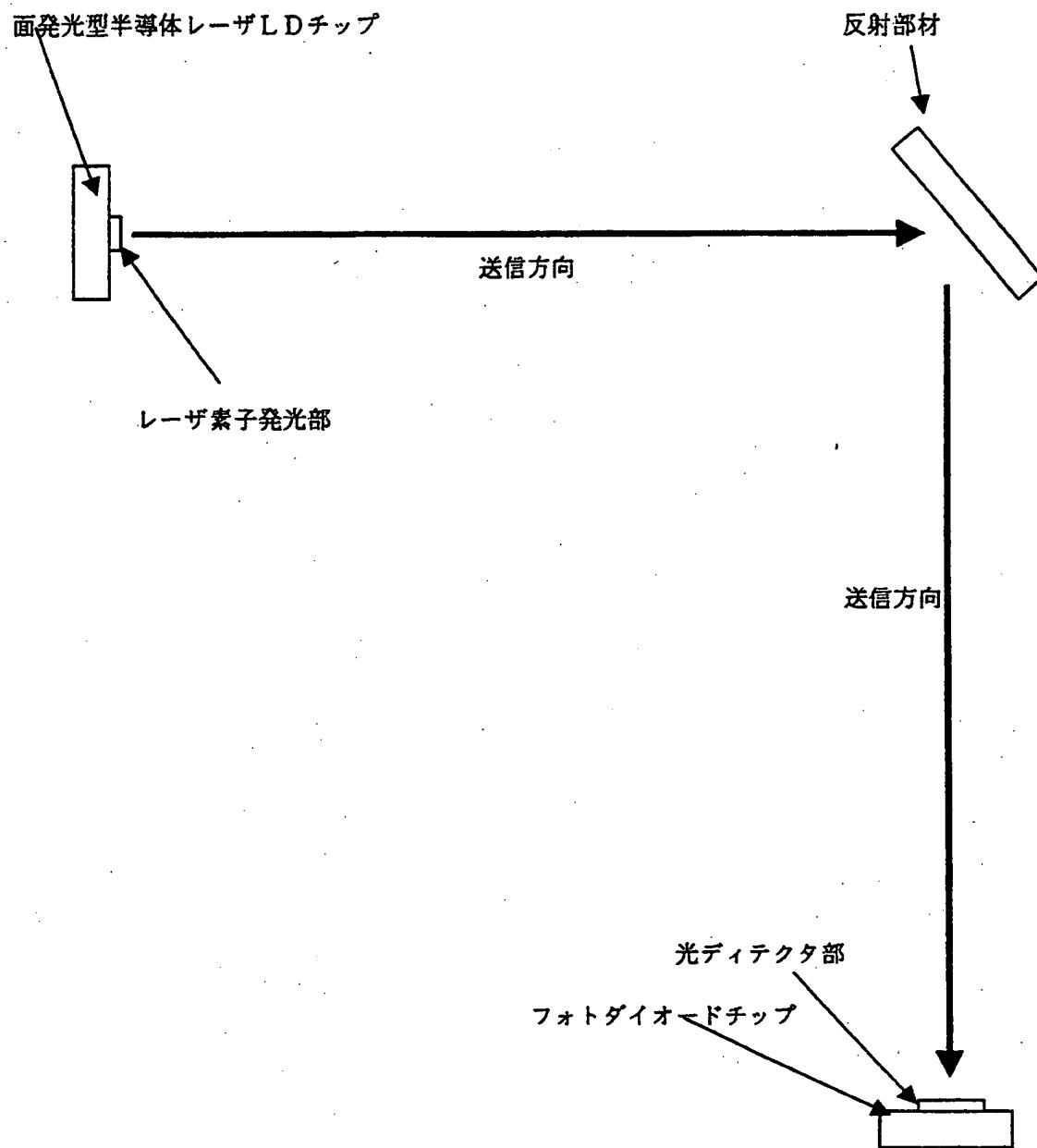
レーザ素子発光部

光ディテクタ部

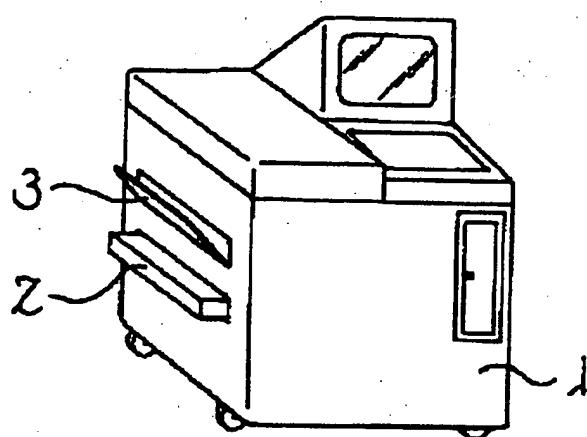
送信方向



【図6】

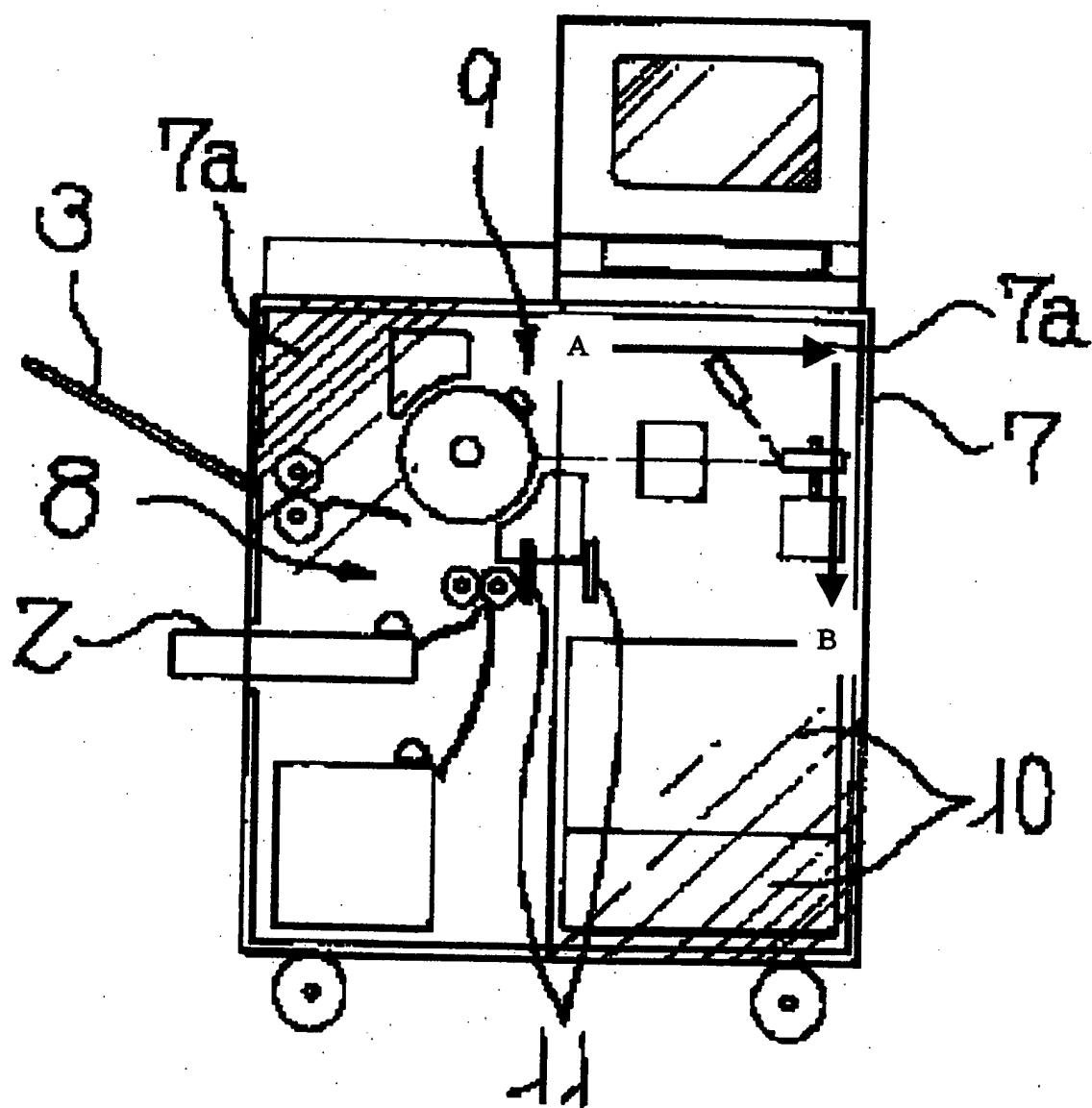


【図7】

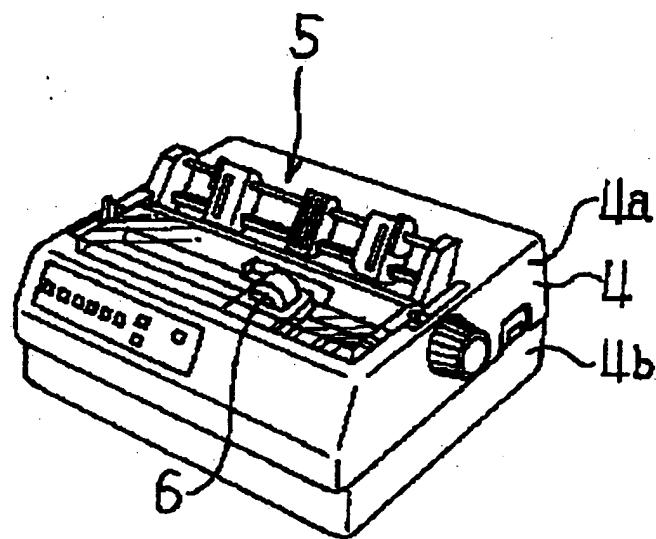


BEST AVAILABLE COPY

【図8】

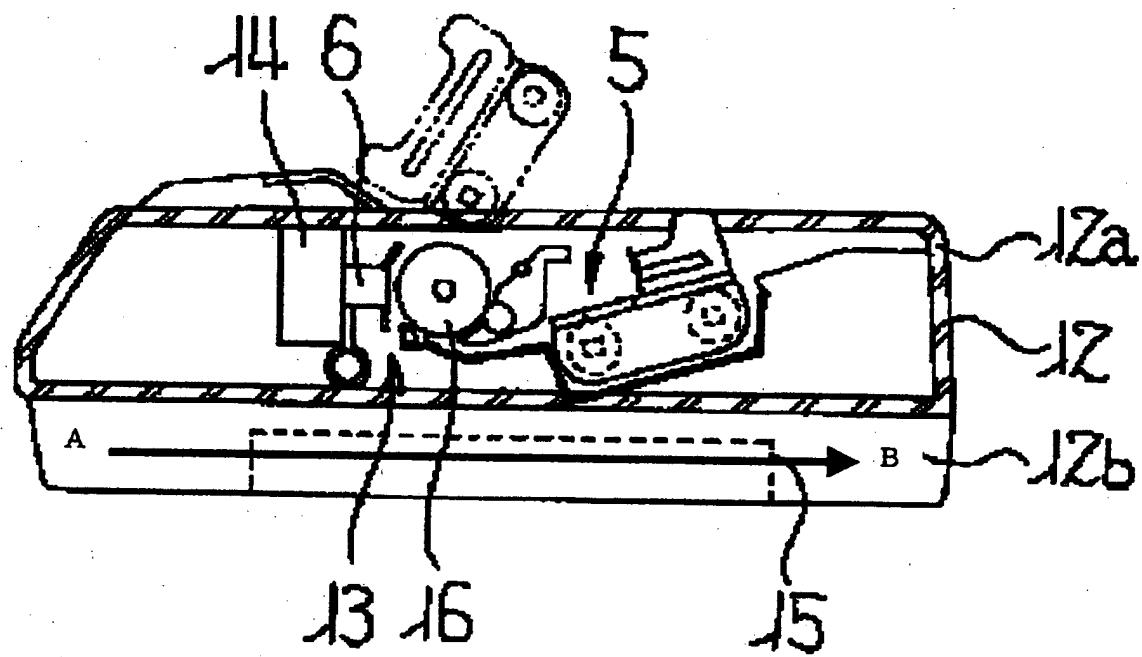


【図9】



BEST AVAILABLE COPY

【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 安定して動作する光送受信システムを提供する。

【解決手段】 レーザ素子発光部から出た光信号は空間伝送されて直進し、フォトダイオード等の受光素子の光ディテクタ部において受け取られることにより信号の送受信を行うことができる。従来このような信号のやりとりは導線ケーブルを用いる電気信号により行われていたが、導線ケーブルの配置や組立の煩雑さが問題となっていた。発振波長1.1から1.7 μ m帯の長波長帯面発光半導体レーザを用いた光送受信システムによれば、電気信号を光信号に置き換えて光信号を空間伝送させることができるために、機器内部の導線ケーブルを削減することができる。これにより導線ケーブルのレイアウト上の処理の煩雑さから開放され、機器内部の部品・ユニット等のレイアウトの自由度が大きくなり、安定した動作を行うことができるレイアウトを実施することが可能となる。

【選択図】 図5

BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 手続補正書
 【提出日】 平成13年 3月26日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【事件の表示】

【出願番号】 特願2001- 53200

【補正をする者】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 関谷 卓朗

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 桜井 彰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 加藤 正良

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 古田 輝幸

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 宮垣 一也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 金井 健

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 和多田 篤行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 俊一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 鈴木 幸栄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 菅原 哲

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 曜地 秀一

【発明者】

BEST AVAILABLE COPY

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】

佐藤 新治

【その他】

発明者の住所又は居所、氏名に変更はないが、順番を変更したいので本補正をします。

【プルーフの要否】 要